

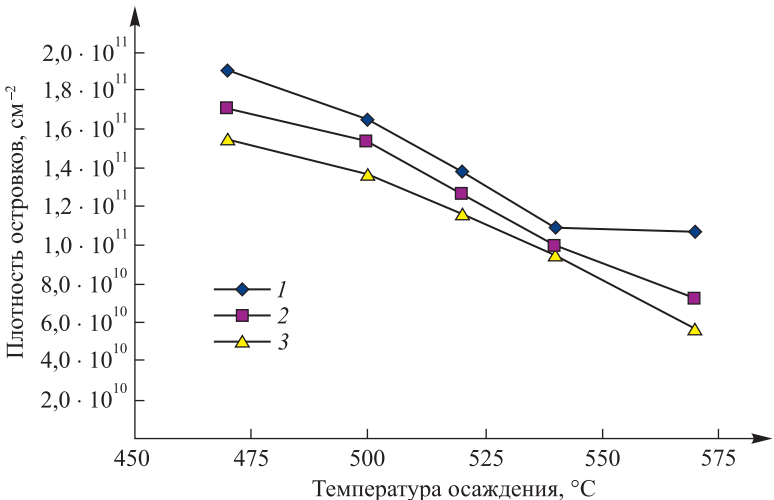


Рис. 2. Зависимость плотности островков $\text{Si}_{1-x}\text{Ge}_x$ от температуры осаждения при различной длительности осаждения: 1 – 180 с; 2 – 300 с; 3 – 420 с

Fig. 2. Dependence of the density of $\text{Si}_{1-x}\text{Ge}_x$ islands on the deposition temperature at different deposition times: 1 – 180 s; 2 – 300 s; 3 – 420 s